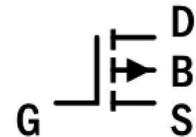


SMY52 Vergleichstyp: MEM517

Si-MOS-Feldeffekttransistor vom p-Kanal-Anreicherungstyp (selbstsperrend) für digitale Anwendungen im DIL-Plastgehäuse der Bauform G4 (DIL4) nach TGL 11811.

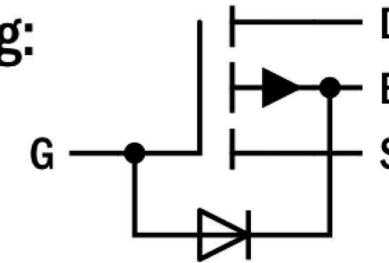
Der Transistor hat eine integrierte Gateschutzdiode, der Substratanschluß ist getrennt herausgeführt.

Anschlußbelegung und
elektrisches Schaltbild:
Masse 0,3 g



B Bulk
D Drain
G Gate
S Source

Schutzbeschaltung:
(intern)



Grenzwerte (gültig für den Betriebsumgebungstemperaturbereich)

Kennwert		max. Wert bzw. Bereich	Meßbedingungen
Drain-Source-Spannung	UDS	-31 ... +0,3 V	
Gate-Source-Spannung	UGS	-31 ... +0,3 V	
Drain-Gate-Spannung	UDG	-31 ... +31 V	
Source-Bulk-Spannung	USB	-15 ... +0,3 V	
Gate-Bulk-Spannung	UGB	-31 ... +0,3 V	
Drain-Bulk-Spannung	UDB	-31 ... +0,3 V	
Drainstrom	-ID	60 mA	
Flußstrom der Gateschutzdiode	IGS	0,1 mA	
Impulsflußstrom der Gateschutzdiode	IGSM	2 mA	$t_p : T = 1 : 10, t_{pmax} = 1 \mu s$
Zulässige Gesamtverlustleistung	Ptot	300 mW	$\delta a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Betriebsumgebungstemperaturbereich	δa	-25 ... +85 °C	
Lagerungstemperaturbereich	δg	-40 ... +125 °C	

Informationskennwerte bei $\delta a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

Drainstrom	-ID	(?) mA	-UDS = -UGS = 10 V
Steilheit	Y21	12,5 mA/V	-UDS = UGS = 10 V, f = 1 kHz
Drain-Source-Widerstand	RDS	(?)	-UGS = 20 V, -ID = 100 μA